ESSAM

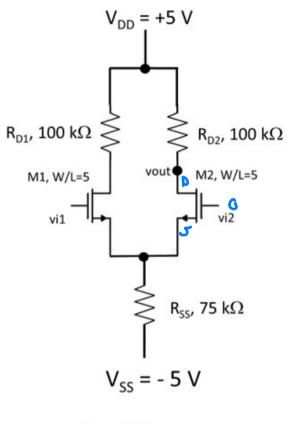
MOS DIF

by www.stefanoivancich.com

same 2018-06-19

Con riferimento all'amplificatore differenziale mostrato in figura, supponendo che i transistor MOSFET a canale n M1 ed M2 siano identici e con W/L =5, con i parametri elettrici indicati,

- 1) Identificare il punto operativo V_{GSQ}, I_{DQ}, V_{DSQ} dei transistor, nell'ipotesi che gli ingressi v_{i1} e v_{i2} siano a massa
- 2) dopo aver risolto l'equazione di secondo grado relativa al calcolo delle tensioni e correnti nel punto operativo, verificare che i transistor siano in saturazione e che la somma di V_{DS} e delle cadute di tensione su R_{D1} e su R_{SS} corrisponda a V_{DD} + V_{SS}
- calcolare la potenza dissipata dalla resistenza R_{ss}
- Calcolare la transconduttanza gm dei transistor M1 ed M2 nel punto operativo
- 5) Calcolare il guadagno differenziale $v_{out}/(v_{i1}-v_{i2})$ con $v_{i1}=v_{id}/2$ e $v_{i2}=-v_{id}/2$
- Calcolare il guadagno di modo comune v_{out}/v_{icm} con v_{i1}=v_{i2}=v_{icm} e il CMRR



$$V_{Tn} = +0.5 \text{ V}$$

 $k'_n = 200 \mu\text{A/V}^2$
 $\lambda = 0 \text{ V}^{-1}$

21 COOME 20NO 21WWE LUICI = CONZIDEBO 2010 WESSO CIECNITO

$$\begin{cases} I_{D1} = \frac{1}{2} k_{m}' (W/L) (V_{G5} - V_{b})^{2} \\ V_{G5} = V_{G} - V_{5} = -(2R_{55}I_{D1} + V_{55}) = 5 - 150K \cdot I_{D1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{2 \cdot I_{D1}}{k_{W}(W/L)} = (5 - 150K \cdot I_{D1} - V_{E})^{2} = 20.25 + 2.25 \cdot 10^{10} \cdot I_{D1}^{2} - 1.35MI_{D1}$$

$$\Rightarrow 2.25 \cdot 10^{10} \cdot \text{Jp}_{1}^{2} - 1.352 \text{M} \text{Lp}_{1} + 20.25 = 0$$

$$\Rightarrow 2.25 \cdot 10^{10} \cdot \text{Jp}_{1}^{2} - 1.352 \text{M } \text{I}_{D} + 20.25 = 0$$

$$\text{ID}_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^{2} - 4\alpha c}}{2\alpha} = \frac{1.352 \text{M} \pm 7351}{5.5 \cdot 10^{10}} = \frac{2.85 \cdot 10^{-5}}{5.5 \cdot 10^{10}} \Rightarrow \text{VGD} = 1.83, \text{VG}_{5} = 0.24$$

$$\text{NO}$$

$$V_{D5} = V_{D} - V_{5} = -V_{6D} - C - V_{65} = 2.9 V$$



- 2) · VERIFICO SATURAZIONE: ____
 - $V_{DD} + (-V_{S}) = R_D I_1 + V_{DS} + 2R_{SS} I_D = 10$ OK

3)
$$\beta_{822} = \beta^{22} \cdot (51^{81})_{5} = \cdots$$

MODO DIFFEREUZIALE: SOURCE CONNESSI A MASSIA

$$v_{\hat{s}_1} = \frac{v_{\hat{s}_0}}{2} \circ \frac{c}{c}$$

Vo= - RD gm V652= RD gm V=D/2

$$\underline{A_D} = \frac{v_o}{v_{i_1} - v_{i_2}} = R_D gm/2 = 12$$

6) MODO COMUNE: Source STACATI

$$V_{\tilde{a}1} = V_{\tilde{a}CM} \circ C$$

$$\begin{cases}
R_{D} & \downarrow \\
N_{M}V_{GS1} & \downarrow \\
N_{M}V_{GS2}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
N_{M}V_{GS2} & \downarrow \\
N_{M}V_{GS2}
\end{cases}$$

VG52= VG-VJ= Vicm - 2R55 gm VG52 = VG52= Vicm/(1+2R55 gm) Va= - RD gm VG52

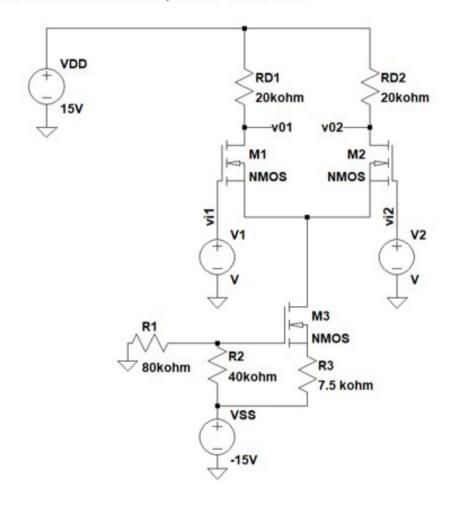
 $Acm = v_0/v_{icm} = - Rpgm/(1 + 2Rssgm) = -0.65$

$$\underline{\text{CMRR}} = \frac{|A_{\text{A}}|}{|A_{\text{CM}}|} = 18.46 = 25.3 \text{ dB}$$

Esame 2018-07-04 1

Nel circuito in figura, tutti i transistor hanno tensione di sogli VT= 1 V, kn = 400 μ A/V², λ = 0 V¹

- 1. Trovare la tensione V_{GS3} del transistor M3
- 2. Trovare la corrente di drain di M3
- 3. Trovare la tensione V_{GS12} dei transistor M1, M2
- 4. Verificare che tutti i transistor siano in saturazione
- 5. Calcolare la transconduttanza di M1, M2 nel punto di lavoro



$$V_{G3} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{GS} = -10 V$$

$$V_{33} = V_{55} + R_3 I_3 = -15 + R_3 I_3$$

$$I_3 = \frac{1}{2} km (V_{653} - V_t)^2 = \frac{1}{2} km (4 - R_3 I_3)^2$$

$$\Rightarrow \frac{2I_3}{K_m} = 16 + R_3^2 I_5^2 - 8R_3 I_3 \Rightarrow R_3^2 I_5^2 - (8R_3 + 2/K_m) + 16 = 0$$

$$\Rightarrow$$
 56.25M $I_3^2 - 65 \text{ k } I_3 + 16=0$

$$\underline{\Gamma_{51/2}} = \frac{65 \, \text{k} \pm 25 \, \text{k}}{112.5 \, \text{M}} = \frac{3.56 \cdot 10^{-1}}{8 \cdot 10^{-1}} \Rightarrow \underbrace{V_{653}} = 2.33 > V_t \Rightarrow 0 \, \text{k}$$

CIRCUITO SIMMETRICO: POSSO CONSIDERARE SOLO METÁ con $I_1 = I_2 = I_3/2 = 1.78 \cdot 10^{-5} A$

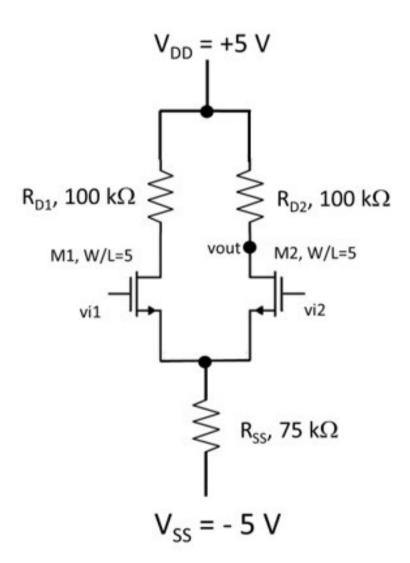
$$||\nabla u_{0}|| = \frac{1}{2} ||\nabla u_{0}|| + ||\nabla u_{0}|| = \frac{1}{2} ||\nabla u_{0}|| + ||\nabla u_{0}|| = \frac{1}{2} ||\nabla u_{0}|| + ||\nabla$$

4) VD3=VS1 = VG1-VGS1=0-1.99=-1.99 V6D3=V63-VD3=-10-(-1.99) = -8.06 < V+ > OK VGD1=VGD2=VG1-VD1=Q-(VDD-RD, I)=-11.49 <Vt =>OK

 $9m_1 = 9m_2 = km(V\omega_1 - V_t) = 3.76 \cdot 10^{-4}$

Con riferimento all'amplificatore differenziale mostrato in figura, supponendo che i transistor MOSFET a canale n M1 ed M2 siano identici e con W/L =5, con i parametri elettrici indicati,

- 1) Identificare il punto operativo VGSQ, IDQ, VDSQ dei transistor, nell'ipotesi che gli ingressi via e viz siano a massa
- 2) dopo aver risolto l'equazione di secondo grado relativa al calcolo delle tensioni e correnti nel punto operativo, verificare che i transistor siano in saturazione e che la somma di V_{DS} e delle cadute di tensione su R_{D1} e su R_{SS} corrisponda a V_{DD} + V_{SS}
- calcolare la potenza dissipata dalla resistenza R_{ss}
- 4) Calcolare la transconduttanza gm dei transistor M1 ed M2 nel punto operativo
- 5) Calcolare il guadagno differenziale vout/(vi1-vi2) con vi1=vid/2 e vi2= vid/2
- 6) Calcolare il guadagno di modo comune vout/vicm con vi1=vi2=vicm e il CMRR in dB



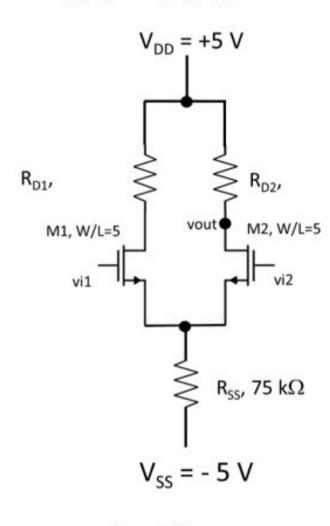
 $V_{Tn} = +0.5 \text{ V}$ $k'_n = 200 \,\mu\text{A/V}^2$ $\lambda = 0 \,\text{V}^{-1}$

ESAME IDENTICO A 2018-06-19

Esame 2018-07-18

Con riferimento all'amplificatore differenziale mostrato in figura, supponendo che i transistor MOSFET a canale n M1 ed M2 siano identici e con W/L =5, con i parametri elettrici indicati e R_{D1} = R_{D2} = 50 k Ω ,

- 1) Identificare il punto operativo V_{GSQ}, I_{DQ}, V_{DSQ} dei transistor, nell'ipotesi che gli ingressi v_{i1} e v_{i2} siano a massa
- 2) dopo aver risolto l'equazione di secondo grado relativa al calcolo delle tensioni e correnti nel punto operativo, verificare che i transistor siano in saturazione e che la somma di V_{DS} e delle cadute di tensione su R_{D1} e su R_{SS} corrisponda a V_{DD} + $|V_{SS}|$
- 3) calcolare la potenza dissipata dalle resistenza RD1 e RD1 e dai transistor
- 4) Calcolare la transconduttanza gm dei transistor M1 ed M2 nel punto operativo
- 5) Calcolare il guadagno differenziale $v_{out}/(v_{i1}-v_{i2})$ con $v_{i1}=v_{id}/2$ e $v_{i2}=-v_{id}/2$
- 6) Calcolare il guadagno di modo comune vout/vicm con vi1=vi2=vicm e il CMRR

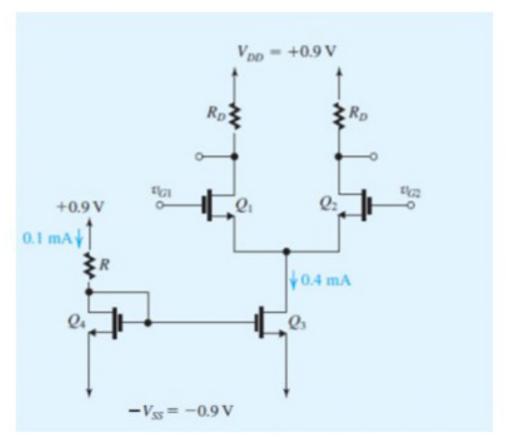


 $V_{Tn} = +0.5 \text{ V}$ $k'_{n} = 200 \,\mu\text{A/V}^{2}$ $\lambda = 0 \,\text{V}^{-1}$

ESAME IDENTICO A 2018-06-19

MA CON PD1 = RD2 = 50 KJ

Esame 2018-07-18



Dato il circuito in figura, nel quale la tensione di sogli dei transistor è $Vtn = 0.4 V e kn' = 0.4 mA/V^2$, (W/L)1=(W/L)2=44.4, (W/L)3=88.8, (W/L)4=22.2.

Determinare il punto di lavoro di Q4, la corrente di drain di Q3, Q1, Q2. Verificare che i transistor si trovino in saturazione. Calcolare la transconduttanza gm di Q1 e Q2, il guadagno differenziale dell'amplificatore, il guadagno di modo comune e il CMRR, tutti con uscita *single-ended* e nell'ipotesi che λ =0. Cosa cambia se λ è diverso da 0?

- 1) IDQ4 =
- 2) caduta di tensione su R =, caduta VDSQ4 =
- 3) ID3 =; ID1 =; ID2 =
- 4) Verifica saturazione
- 5) Transconduttanza gm =
- 6) Guadagno differenziale =
- 7) Guadagno di modo comune e CMRR =

1)
$$t_{D4} = 0.1 \text{ mA}$$

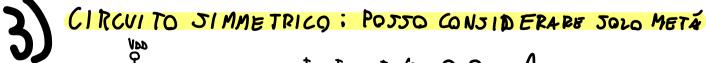
$$t_{D4} = \frac{1}{2} t_{\text{m}} (\text{W/L})_{\text{H}} (\text{V}_{GSH} - \text{V}_{\text{L}})^2 \Rightarrow \underline{\text{V}_{GSH}} = \sqrt{\frac{2 t_{DH}}{k_{\text{m}}} (\text{W/L})_{\text{H}}} + U_{\text{L}} = \underline{\alpha} 51 \text{ V} > \text{V}_{\text{L}} \Rightarrow 0 \text{ K}$$

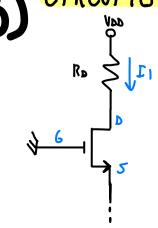
$$V_{GDH} = 0 < V_{\text{L}} \Rightarrow 0 \text{ K}$$

$$= V_{DSH}$$

$$Q_{\text{H}} = V_{DSH} = V_{DSH} = V_{DSH} = V_{DSH} - V_{SS} - V_{GSH} = \underline{\alpha} 99 \text{ V}$$

$$V_{\text{L}} = V_{\text{L}} = V_{\text{L}}$$





4)
$$I_1 = \frac{1}{2} k_m'(W/L)_1 (V_{651} - V_b)^2 \Rightarrow V_{651} = \sqrt{\frac{2 + D_1}{k_m'(W/L)_1}} + U_b = 0.55 V > V_b \Rightarrow 0 K$$

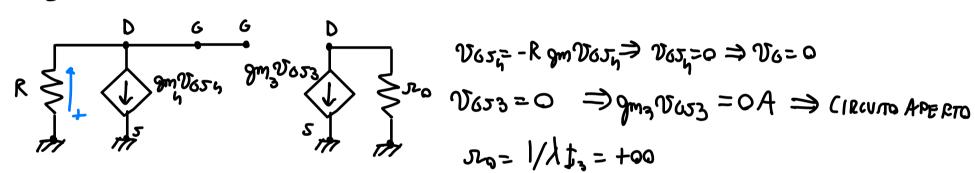
$$= V_{652} = -V_{51} = -V_{52}$$

5)
$$9m_1 = 9m_2 = km'(V/L), (Vos, -Vos) = 2.664.10^{-3}$$

6) MODO DIFFERENZIALE: SOURCES CONNESSI A MASSA

$$A_D(SINGLE)_1 = \frac{v_{01}}{v_{50}} = -\frac{R_D gm}{2} = -8.658$$

7) MODO COMUNE: JOURCES STACKATI

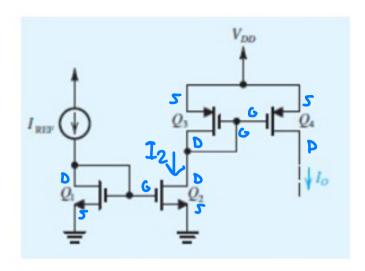


$$V_{G_{1}} = V_{G_{1}} = V_{G$$

CMRR(SINGLE) = 2010GLO
$$\frac{|A_D|_{S}}{|A_{CM}|_{S}} = \frac{|A_D|_{S}}{|A_{CM}|_{S}} = \frac{|A_D|_{S}}{|A_{CM}|_{S}} = \frac{|A_D|_{S}}{|A_{CM}|_{S}} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_{CM}|_{DIFF}} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_CM}|_{DIFF} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_CM}|_{DIFF}} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_CM}|_{DIFF} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_D|_{DIFF}} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_D|_{DIFF}} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_CM}|_{DIFF} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_CM}|_{DIFF} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_D|_{DIFF}} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_D|_{DIFF}} = \frac{|A_D|_{DIFF}}{|A_D|_{DIFF}}$$

Esame 2018-07-18

Per il circuito in figura, scrivere l'espressione di I_0 in funzione di I_{REF} e del rapporto $(W/L)_i$ i = 1, 2, 3, 4 dei transistor. Assumere λ = 0.



$$I_{3}=I_{2}=\frac{1}{2}k_{m}^{\lambda}(W/L)_{3}(V_{5G3}-|V_{4P}|)^{2} \implies V_{5G3}=\sqrt{\frac{2I_{2}}{k_{m}^{\lambda}(W/L)_{3}}}+|V_{4P}|$$

$$V_{5G4}=V_{5G3}$$

$$I_{0}=\frac{1}{2}k_{m}^{\lambda}(W/L)_{4}(V_{5G4}-|V_{4P}|)^{2}=\frac{1}{2}k_{m}^{\lambda}(W/L)_{4}(\sqrt{\frac{2I_{2}}{k_{m}^{\lambda}(W/L)_{3}}}+|V_{4P}|-|V_{4P}|)^{2}$$

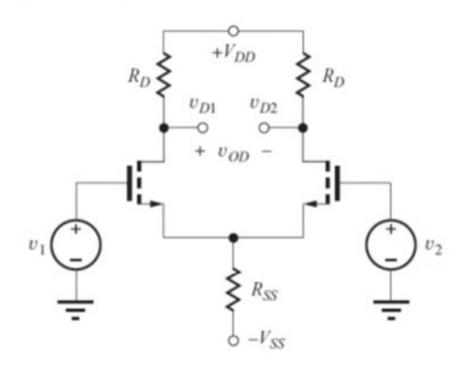
$$=\frac{(W/L)_{4}}{(W/L)_{3}}I_{2}=\frac{(W/L)_{4}}{(W/L)_{3}}\frac{(W/L)_{2}}{(W/L)_{1}}I_{RPP}$$

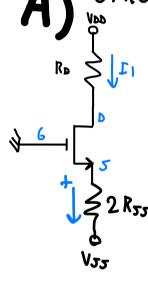
ne 2018-09-1

Dato l'amplificatore operazionale in figura, con V_{DD} = V_{SS} = 15 V, R_{SS} = 62 k Ω , R_D = 62 k Ω , R_D = $400 \,\mu\text{A/V}^2 \,\text{e} \,\text{V}_{TN} = 1 \,\text{V},$

- (a) calcolare il punto operativo dei due transistor
- (b) calcolare il guadagno differenziale
- (c) calcolare il guadagno di modo comune
- (d) calcolare il fattore di reiezione di modo comune
- (e) calcolare la resistenza differenziale di ingresso







CIRCUITO SIMMETRICO: POSSO CONSIDERARE SOLO METÁ

$$V_{GS} = V_G - V_S = -\left(2R_{SS} \cdot I_1 + V_{SS}\right) = 15 - 2R_{SS} I_1$$

$$I_1 = \frac{1}{2} k_m \left(V_{GS} - V_e\right)^2 = \frac{1}{2} k_m \left(16 - 2R_{SS} I_1\right)^2 = 200 \mu \left(196 + 1.5376 I_1^2 - 3.492 M I_1\right)$$

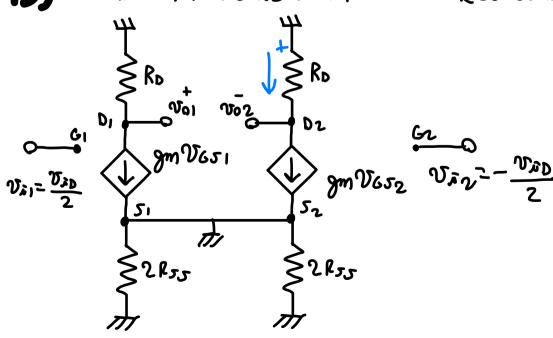
$$\Rightarrow 1.5376 \cdot lo^{10} I_1^2 - 3.481 \cdot lo^6 I_1 + 196 = 0$$

$$\begin{cases} 2R_{55} \Rightarrow \underline{L_{1n}} = \frac{3.481 \cdot 10^{6} \pm 250^{\circ}153}{2 \cdot 1.5376 \cdot 10^{10}} = \frac{1.07 \cdot 10^{-1}}{1.19 \cdot 10^{-1}} \Rightarrow V_{65} = 0.22 < V_{t} \Rightarrow N_{0}$$

$$V_{DJ} = V_{D} - V_{J} = V_{DD} - R_{D} \cdot I_{1} - (2 \cdot R_{JJ} \cdot I_{1} + V_{JJ}) = V_{DD} - V_{JJ} - (R_{D} + 2R_{JJ}) \cdot I_{1} = 8.36$$



MODO DIFFERENZIALE: SOURCES CONNESSIA MASSA



$$9m_1 = 9m_2 = k_m (V_{GJ} - V_{t}) = 2.92 \cdot 10^{-h}$$

 $V_{SD} = V_1 - V_2$

$$A_{\rm D}(\text{single})_{\rm I} = \frac{v_{\rm OI}}{v_{\rm AB}} = -R_{\rm D}\,gm/2 = -9.052$$

$$A_{\rm D}$$
 (SINGLE) $_2 = \frac{v_{\rm o2}}{v_{\rm ED}} = + R_{\rm D} \, gm/2 = + 9.052$

$$A_D(DIPP) = \frac{v_{0D}}{v_{2D}} = P_D gm = 18.104$$

$$V_{GS}=V_{GS}=V_{G}-V_{S}=V_{A}cm-2R_{SS}$$
 Jm V_{GS}
 $\Rightarrow V_{GS}=V_{A}cm/(l+2R_{SS}gm)$
 $V_{A}cm=V_{I}=V_{2}$
 $V_{OI}=-R_{D}$ Jm $V_{GS}=-R_{D}$ Jm $V_{A}cm/(l+2R_{SS}gm)$
 $v_{O2}=-R_{D}$ Jm $V_{GS}=-R_{D}$ Jm $V_{A}cm/(l+2R_{SS}gm)$
 $v_{OD}=v_{O2}-v_{O1}=0$

 $A_{CM}(SINGLE) = \frac{v_{Ol}}{v_{scm}} = \frac{v_{O2}}{v_{scm}} = -R_D gm/(1+2R_{so}gm)$ $A_{CM}(DIFF) = \frac{v_{OD}}{v_{scm}} = 0 = -0.51$

(MRR (SINGLE) = 20106
$$\frac{|A_D|_s}{|A_{cn}|_s} = 20106 \frac{9.052}{0.51} = 24.98 dB$$

$$(MRR(DIFF) = 20106 \frac{|A_D|_{DIR}}{|A_{cm}|_{DIF}} = 20106 \frac{18.104}{0} = +00$$

REJIJTEVZA DIPPERENZIAVE IN INGREDI APPLICO UX TRAIZ INGREDI

$$R_{D}$$

$$R_{D$$

$$R_{\text{IN}}(\text{DIFF}) = \frac{v_{x}}{v_{x}} = v_{x} conversor fx = 0$$

$$= q_{\text{VIND}} v_{x} = Q_{\text{VIND}} v_{x} = 0$$

$$R_{D} = 0$$

$$V_{31} = 0$$

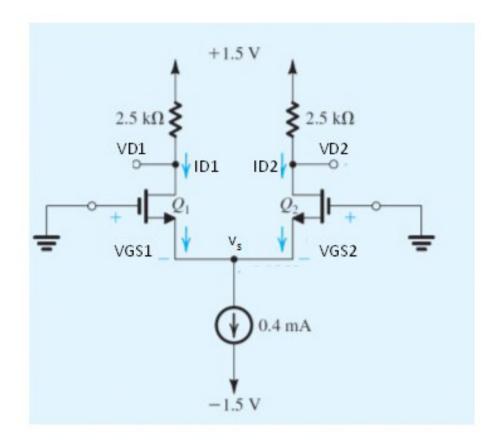
$$V\omega_1 = V\omega_2 = Q$$

$$gm Vos_1 = gm Vos_2 = QA$$

$$\lambda_{x} = \frac{v_{x}}{2R_{D}}$$

$$R_{CC} = \frac{v_{x}}{2R_{D}} = 2R_{D}$$

Esame 2019-01-30



Dato il circuito in figura, nel quale i transistor MOS a canale n ad arricchimento sono caratterizzati da k_n = 4 mA/V^2 , $V_{Tn} = 0.5 V$, si trascuri la modulazione della lunghezza di canale e si calcolino a) le tensioni V_{GS} dei due transistor; (b) le tensioni di drain V₀ dei due transistor; (c) le correnti di drain dei due transistor; (d) la tensione v₅. (e) qual è il valore più alto di v_{CM} per il quale i due transistor si mantengono in saturazione ? (f) sostituire il generatore di corrente con una resistenza connessa tra v₅ e -1.5 V, tale da mantenere una corrente circa pari a 0.4 mA. Supponendo di utilizzare questo circuito come amplificatore differenziale, quanto varrebbe in questo caso il guadagno differenziale, il guadagno di modo comune e il CMRR?



CIRCUITO SIMMETRICO: POSSO CONSIDERARE SOLO METÁ

$$I_1 = I_2 = I/2 = 0.2 \text{ mA}$$

$$1_1 = \frac{1}{2} k_m (V_{651} - V_E)^2 \Rightarrow V_{652} = V_{651} = \sqrt{\frac{2J_1}{k_m}} + V_E = 0.82 > V_E \Rightarrow 0$$

$$V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - R_D I_1 = 1$$

()
$$1_{0,1}=1_{0,2}=1_{1,2}=0.2mA$$

$$\begin{array}{c} \text{CONDI 2 ION I DI : } \begin{cases} V_{G5} \geqslant V_{F} \Rightarrow \\ V_{C} \geqslant V_{F} + V_{D} \end{cases} \Rightarrow -0.32 \leqslant V_{C} \leqslant 1.5 \end{array}$$

MODO DIFFERENZIALE: SOURCES CONNESSIA MASSA

MODO COMUNE: JOURCES STACKATI

$$g_{m} = g_{m} 2 = k_{m} (V_{GS} - V_{E}) = 1.28 \cdot 10^{-3}$$
 $V_{ab} = V_{1} - V_{2}$
 $V_{O1} = -R_{D} g_{m} V_{GS1} = -R_{D} g_{m} V_{ab}/2$
 $V_{O2} = -R_{D} g_{m} V_{GS2} = +R_{D} g_{m} V_{ab}/2$
 $V_{OD} = V_{O1} = R_{D} g_{m} V_{ab}/2$
 $A_{D}(SINGLE)_{1} = \frac{v_{O1}}{v_{ab}} = -R_{D} g_{m}/2 = -1.6$
 $A_{D}(SINGLE)_{2} = \frac{v_{OD}}{v_{ab}} = +R_{D} g_{m}/2 = +1.6$
 $A_{D}(DIFF) = \frac{v_{OD}}{v_{ab}} = R_{D} g_{m} = 3.2$

$$V_{GS}=V_{GS}=V_{G}-V_{S}_{I}=V_{x}cm-2R_{SF}gm)$$

$$\Rightarrow V_{GS}=V_{I}=V_{x}cm/(1+2R_{SF}gm)$$

$$V_{x}cm=V_{I}=V_{2}$$

$$V_{OI}=-R_{D}gmV_{GS}=-R_{D}gmV_{x}cm/(1+2R_{SF}gm)$$

$$v_{O2}=-R_{D}gmV_{GS}=-R_{D}gmV_{x}cm/(1+2R_{SF}gm)$$

$$v_{OD}=v_{O2}-v_{OI}=O$$

$$A_{cm}(s_{inGLF})=\frac{v_{OI}}{v_{x}cm}=\frac{v_{O2}}{v_{x}cm}=-R_{D}gm/(1+2R_{SF}gm)$$

$$A_{Cm}(D_{IFF})=\frac{v_{OD}}{v_{x}cm}=O$$

$$(MRR (JINGLE) = 20106 \frac{|A_D|_{S}}{|A_{cm}|_{S}} = 20106 \frac{1.6}{0.95} = 8.52 dB$$

$$(MRR (DIFF) = 20106 \frac{|A_D|_{DIR}}{|A_{cm}|_{BIE}} = 20106 \frac{3.2}{0} = +00$$